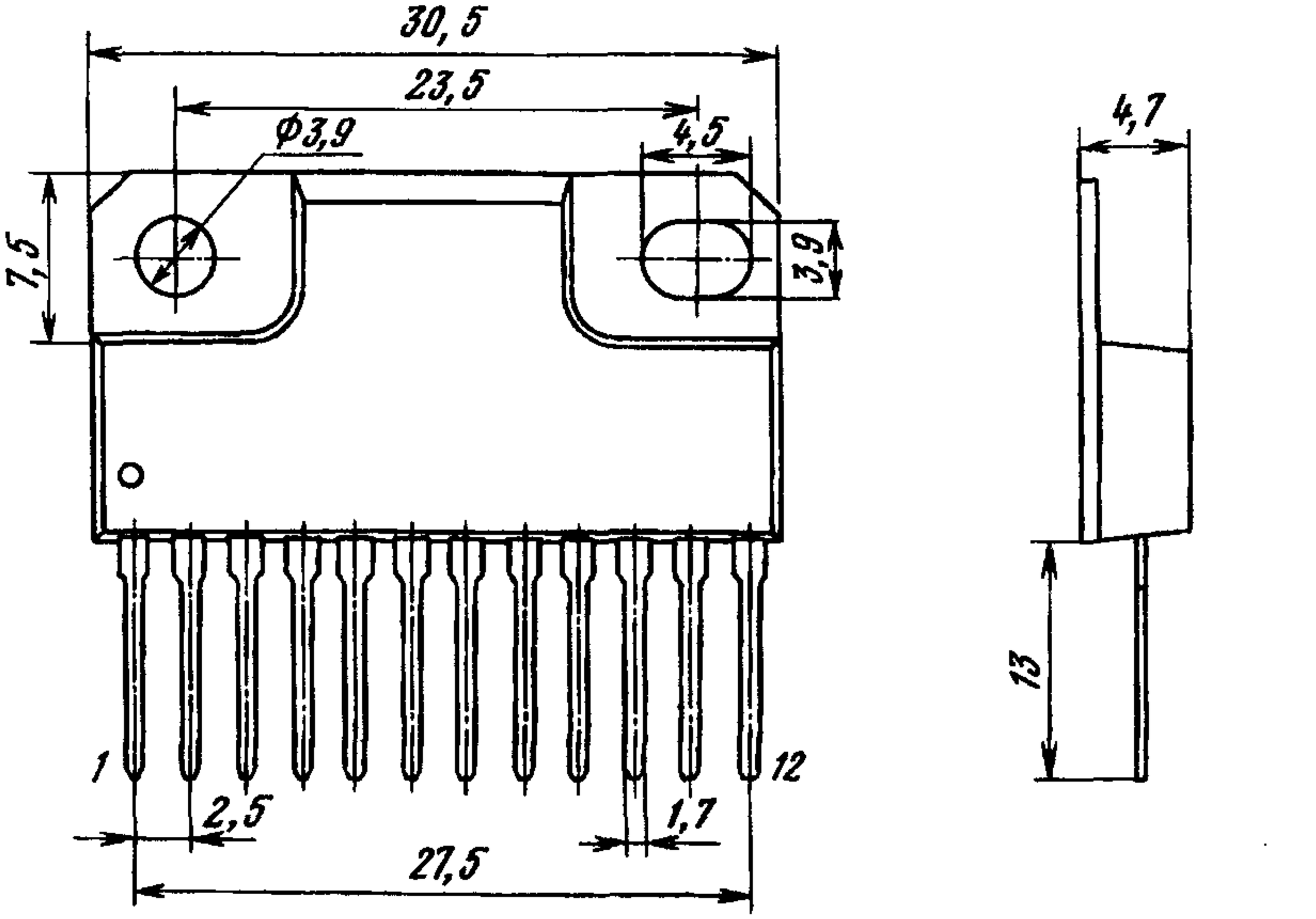
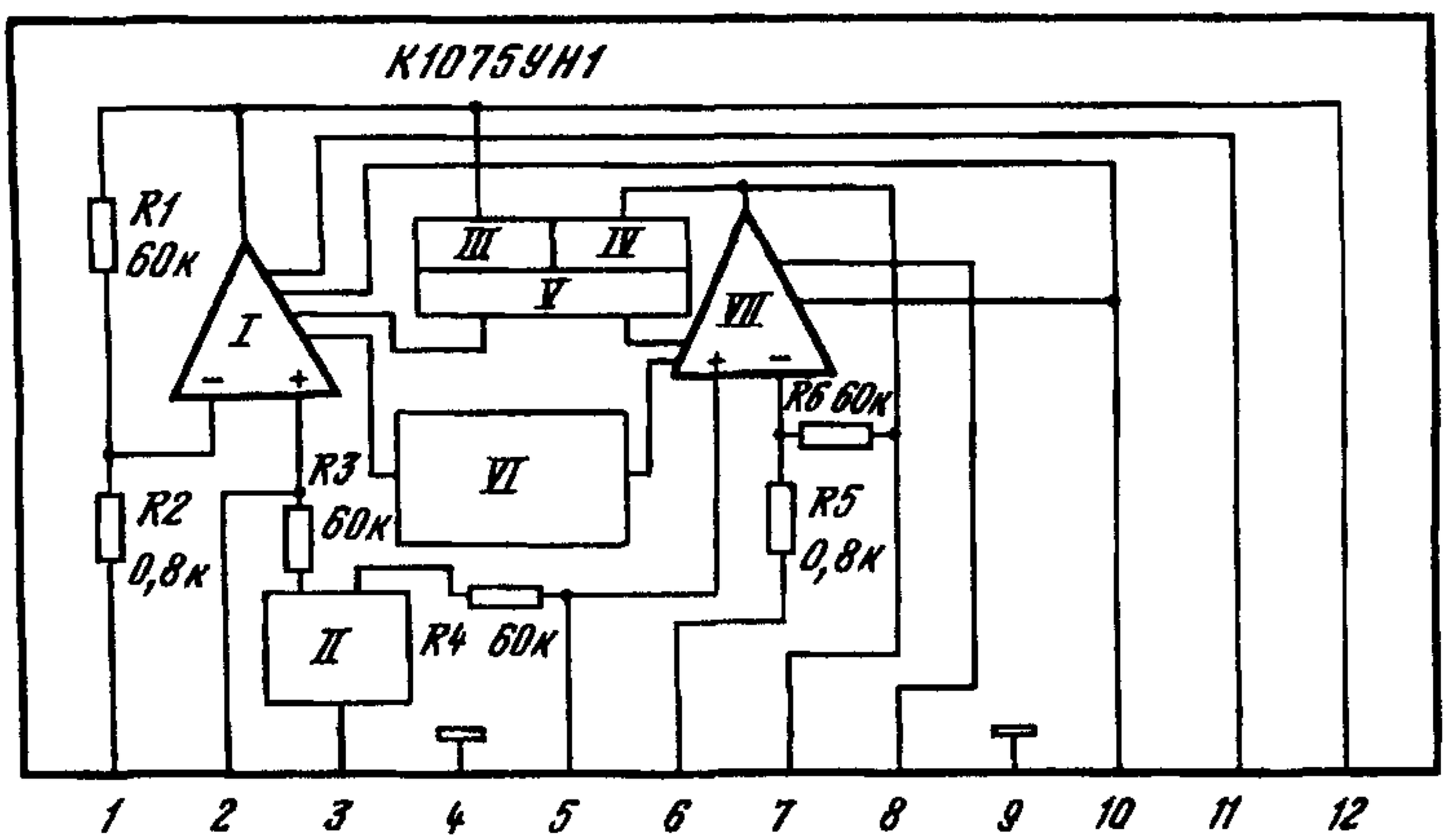
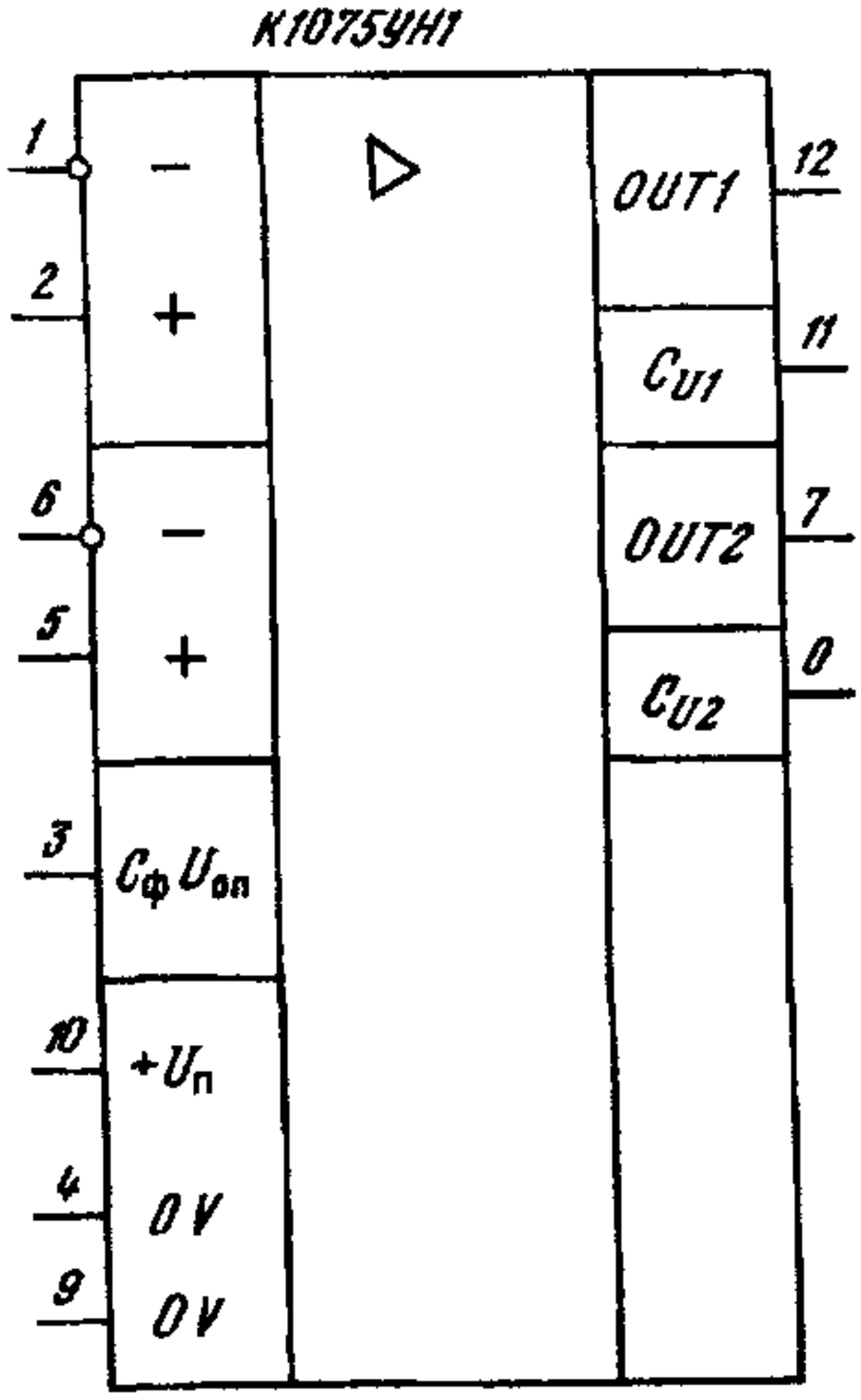
К1075УН1

Микросхема представляет собой двухканальный усилитель с выходной мощностью 2х3,5 Вт на нагрузке в 4 Ом. Имеет встроенную защиту от перегрузок по току выходного каскада, защиту от перенапряженний по цепям питания и защиту кристалла от перегрева. Выполнена по планарно-эпитаксиальной технологии на биполярных транзисторах с изоляцией элементов обратносмещенными p-n переходами. Коиструктивно оформлена в корпусе типа 150Х.12-1. Масса не более 6,5 г.





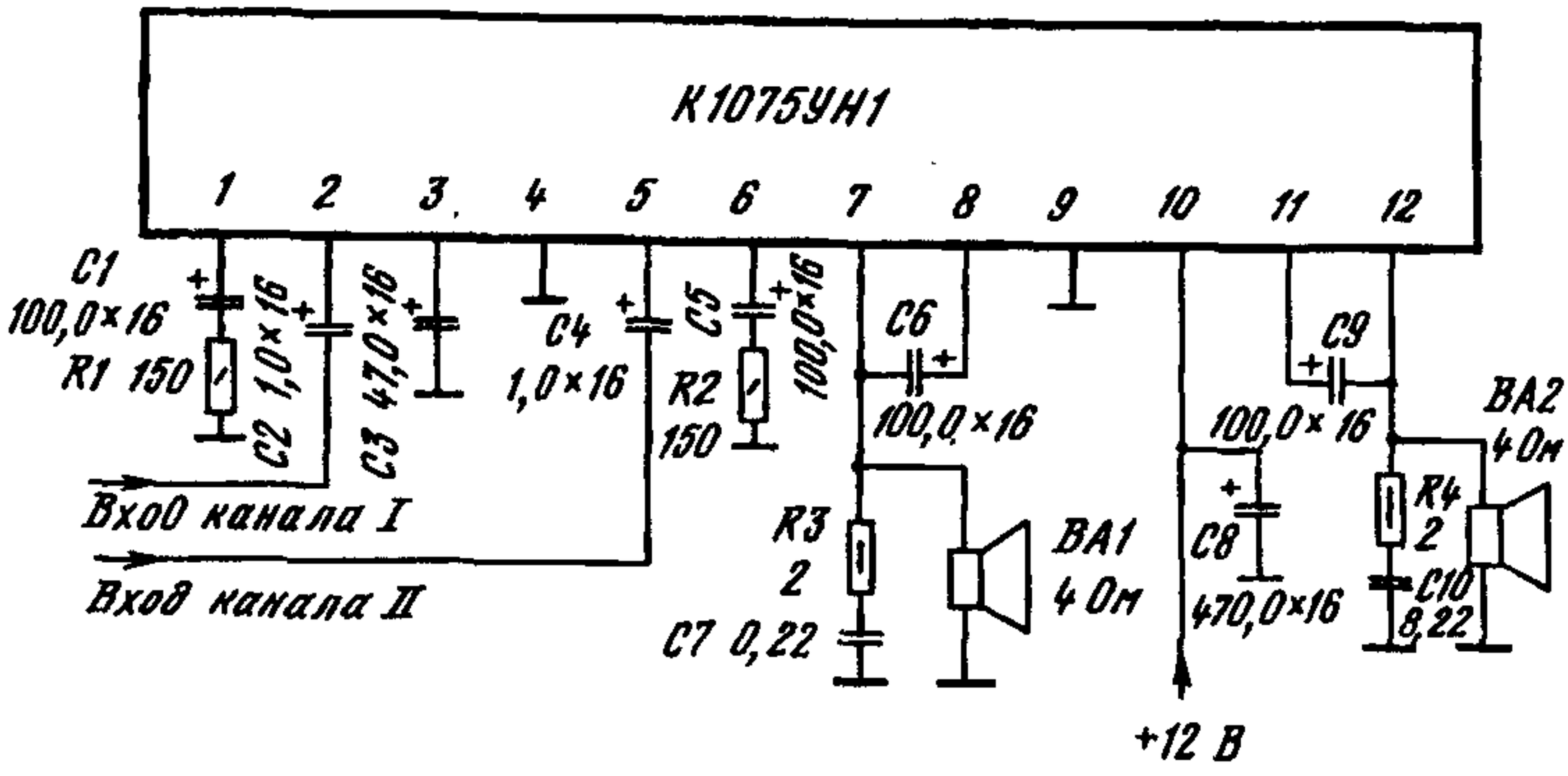


Назначение выводов: 1 — инвертирующий вход усилителя первого канала; 2 — неинвертирующий вход усилителя первого канала; 3 — вывод для подключения фильтрующего конденсатора; 4, 9 — общий ($-U_п$); 5 — неинвертирующий вход усилителя второго канала; 6 — инвертирующий вход усилителя второго канала; 7 — выход усилителя второго канала; 8 — для подключения конденсатора вольтодобавки к оконечному каскаду усилителя второго канала; 10 — напряжение питания ($+U_п$); 11 — вывод для подключения конденсатора вольтодобавки к оконечному каскаду усилителя первого канала; 12 — выход усилителя первого канала.

Основные параметры

Номинальное напряжение питания	12 В
Ток потребления (общий ток покоя) при $U_{вх1} = U_{вх2} = 0$, $U_п = 12$ В, $R_н = 4$ Ом, $T = +25°$ С, не более	50 мА
Выходная мощность одного канала при $R_н = 4$ Ом, $K_г \leq 10$ %, $T = +25°$ С, не менее:	
$U_п = 12$ В	3,5 Вт
$U_п = 6$ В	0,8 Вт
Граничная частота полосы пропускания по уровню −3 дБ при $U_п = 12$ В, $P_{вых} = 2$ Вт, $K_г \leq 1$ %, $R_н = 4$ Ом, $T = +25°$ С:	
нижняя, не более	40 Гц
верхняя, не более	14 кГц
Коэффициент гармоник по частоте входного сигнала 1 кГц при $R_н = 4$ Ом, $T = +25°$ С, не более:	
$U_п = 12$ В, $P_{вых} = 2$ Вт	1 %
$U_п = 6$ В, $P_{вых} = 0{,}1$ Вт	1 %
Коэффициент усиления по напряжению с внутреней обратной связью при $U_п = 12$ В, $P_{вых} = 2$ Вт, $R_н = 4$ Ом, $T = +25°$ С (типовое значение)	36 ±0,5 дБ
Входное сопротивление неинвертирующего входа при $U_п = 12$ В, $T = +25°$ С, не менее	30 кОм
Температура кристалла, при которой происходит срабатывание тепловой защиты	130...140° С
Тепловое сопротивление кристалл — корпус, не более	4° С/Вт

Схема включения



Типовая схема включения ИС К1075УН1